



# 제25회 한국반도체학술대회

The 25<sup>th</sup> Korean Conference on Semiconductors

2018년 2월 5일(월)-7일(수), 강원도 하이원리조트 컨벤션 호텔

2018년 2월 7일(수), 16:15-17:30

Room D (함백II+III, 5층)

## E. Compound Semiconductors 분과

### [WD4-E] SiC Device

<p>WD4-E-1 16:15-16:30</p>	<p><b>Low Frequency Noise in SiC Double-Implant MOSFETs</b> Sangwon Baek, Iksoo Park, Rockhyun Baek, and Jeong-soo Lee <i>Department of Electrical Engineering, POSTECH</i></p>
<p>WD4-E-2 16:30-16:45</p>	<p><b>1.2 kV 급4H-SiC 쇼트키장벽 다이오드의 전기적 특성 최적화를 위한 에피층 및 접합종단구조 설계</b> 박힘찬<sup>1,2</sup>, 한상보<sup>1</sup>, 방욱<sup>2</sup>, 김동영<sup>3</sup>, 이현수<sup>3</sup>, 금주연<sup>4</sup>, 강인호<sup>2</sup> <sup>1</sup>경남대학교 첨단공학과, <sup>2</sup>한국전기연구원 전력반도체연구센터, <sup>3</sup>경상대학교 반도체공학과, <sup>4</sup>창원대학교 신소재융합공학과</p>
<p>WD4-E-3 16:45-17:00</p>	<p><b>5kV 급 4H-SiC 쇼트키 접합 다이오드의 전기적 특성 및 소재 분석</b> 금주연<sup>1,2</sup>, 나문경<sup>2</sup>, 강인호<sup>2</sup>, 방욱<sup>2</sup>, 구본훈<sup>1</sup> <sup>1</sup>창원대학교 신소재융합공학과, <sup>2</sup>한국전기연구원 전력반도체연구센터</p>
<p>WD4-E-4 17:00-17:15</p>	<p><b>High Current Density and High Breakdown Voltage of 4H-SiC Trench MPS Applying JTE Structure</b> 김동영<sup>1,2</sup>, 석오균<sup>2</sup>, 방욱<sup>2</sup>, 김형우<sup>2</sup>, 박기철<sup>1</sup> <sup>1</sup>경상대학교 반도체 공학과, <sup>2</sup>한국전기연구원 전력반도체연구센터</p>
<p>WD4-E-5 17:15-17:30</p>	<p><b>Analysis of 4H-SiC Fin-Type VDMOSFET for Low on-Resistance</b> Dongwoo Bae, Doohyung Cho, and Kwangsoo Kim <i>Department of Electronic Engineering, Sogang University</i></p>